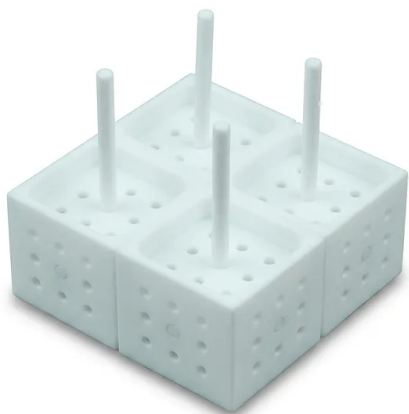


Индивидуальная Химически Стойкая Корзина-«Цветок» Из Птфэ Для Очистки Пластин, Травления Полупроводников И Обработки В Отрасли Новых Источников Энергии

Артикул: PL-CP149



введение

Оптимизируйте производство полупроводников и изделий в сфере новых источников энергии с помощью индивидуальных корзин-«цветков» из ПТФЭ для очистки пластин. Разработанные для экстремальной химической стойкости в процессах травления и RCA-очистки, эти держатели из фторполимера высокой чистоты обеспечивают целостность процесса и долговечность в требовательных промышленных условиях.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
RCA-очистка полупроводников	Последовательная очистка кремниевых пластин с использованием растворов SC-1 и SC-2 для удаления органических и металлических загрязнений.	Нулевое загрязнение и устойчивость к смесям аммиака/пероксида.
Травление плавиковой кислотой (HF)	Удаление собственного оксида или контролируемое травление слоев диоксида кремния на поверхностях пластин.	Абсолютная устойчивость к HF, которая растворила бы альтернативы из стекла или кварца.
Текстурирование фотоэлементов	Мокрое химическое травление монокристаллических или поликристаллических кремниевых пластин для создания светозахватывающих поверхностей.	Стабильное выравнивание пазов обеспечивает равномерное текстурирование в больших партиях.
Обработка в растворе «пириания»	Агрессивное удаление органических остатков и фоторезиста с использованием серной кислоты и перекиси водорода.	Выдерживает экстремальные экзотермические реакции и высокотемпературную кислотность.
Полоскание после ХМП (CMP)	Критическая очистка пластин после химико-механической полировки для удаления абразивных суспензий.	Гладкие поверхности и высокий дренаж предотвращают повторное осаждение частиц.
Подготовка полупроводниковых соединений	Специализированная очистка пластин GaAs или InP для производства передовых электронных и оптоэлектронных устройств.	Настраиваемая геометрия пазов для нестандартных толщин и размеров пластин.
Загрузка микроканальных реакторов	Позиционирование подложек внутри индивидуальных реакционных камер для контролируемого химического осаждения из газовой или жидкой фазы.	Адаптированные размеры позволяют идеально вписаться в нестандартные лабораторные установки.
Проявление в литографии	Удержание подложек во время проявления и удаления слоев фоторезиста в процессах микроfabrication.	Устойчивость к растворителям гарантирует, что держатель не разрушится и не будет выделять газы в процессе.
Параметр	Детали спецификации для PL-CP149	
Идентификатор модели	Серия PL-CP149	
Материал конструкции	100% исходный ПТФЭ высокой чистоты (политетрафторэтилен)	

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Детали спецификации для PL-CP149	
Метод изготовления	Полная индивидуальная обработка на ЧПУ	
Химическая совместимость	Универсальная (Кислоты, Щелочи, Растворители, Окислители, HF)	
Диапазон рабочих температур	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)	
Совместимость с пластинами	Настраиваемая для 2", 3", 4", 6", 8", 12" или нестандартных размеров	
Конфигурация пазов	Полностью настраиваемая (переменный шаг, ширина и глубина)	
Количество пазов	Определяется по требованию клиента (например, емкость 10, 25, 50)	
Конструкция ручки	Встроенная, съемная или удлиненная (настраиваемая длина)	
Отделка поверхности	Гладкая, малопористая обработанная поверхность	
Стандарт чистоты	Подходит для трасс-анализа и использования в чистых помещениях класса 10/100	
Дренажные особенности	Настраиваемые дренажные отверстия снизу/сбоку	